

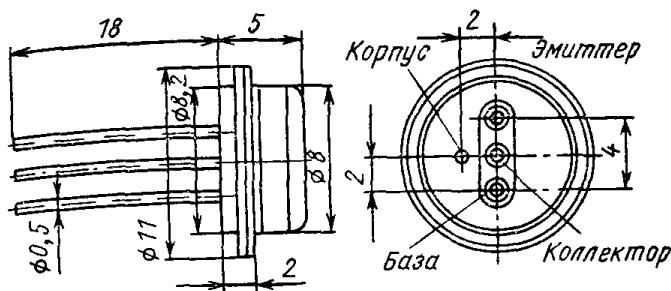
1T313А, 1T313Б, 1T313В, ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные *p-n-p* универсальные

Предназначены для усиления сигналов высокой и сверхвысокой частот и для работы в схемах переключения

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами
Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 2 г



Электрические параметры

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала

при $U_{KB} = 5$ В, $I_E = 5$ мА:

при $T = 298$ К:

1T313А	20 – 250
1T313Б	20 – 80
1T313В	60 – 250
ГТ313А, ГТ313Б	20 – 200
ГТ313В	30 – 170

типовое значение*:

1T313А	80
1T313Б	47
1T313В	93

при $T = 233$ К ГТ313А, ГТ313Б, ГТ313В 15 – 200

при $T = 328$ К:

ГТ313А, ГТ313Б	20 – 400
ГТ313В	30 – 350

Модуль коэффициента передачи тока при $U_{KB} = 5$ В,

$I_E = 5$ мА, $f = 100$ МГц:

1T313А	3 – 10
1T313Б, 1T313В, ГТ313Б	4,5 – 10
ГТ313А, ГТ313В	3,5 – 10

типовое значение*:

1T313А	4,7
1T313Б, 1T313В	5,2

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 3$ В, $I_Э = 15$ мА:

при $T = 298$ К:

1T313A	10 – 230
1T313Б	10 – 75
1T313В	30 – 230

при $T = 213$ К От 1 до 0,5 значения при $T = 298$ К

при $T = 343$ К От 1 до 2,5 значений при $T = 298$ К,
но не более 500

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 12$ В не более:

при $T = 213$ и 298 К 1T313A, 1T313Б, 1T313В	5 мкА
при $T = 233$ и 298 К ГТ313A, ГТ313Б, ГТ313В	5 мкА
при $T \approx 328$ К ГТ313A, ГТ313Б, ГТ313В	50 мкА
при $T = 343$ К 1T313A, 1T313Б, 1T313В	40 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 0,4$ В не более

1T313A, 1T313Б, 1T313В	30 мкА
ГТ313A, ГТ313Б, ГТ313В	50 мкА

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В не более 2,5 пФ
типовое значение * 1T313A, 1T313Б, 1T313В 1,5 пФ

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 5$ В,
 $I_Э = 5$ мА, $f = 5$ МГц не более

1T313A, ГТ313A, ГТ313В	75 пс
1T313Б, 1T313В, ГТ313Б	40 пс
типовое значение *	

1T313A	38 пс
1T313Б	17 пс
1T313В	20 пс

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 15$ мА,

$I_B = 1,5$ мА не более	0,7 В
типовое значение *	

1T313A, 1T313В	0,4 В
1T313Б	0,45 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_К = 15$ мА,

$I_B = 1,5$ мА не более	0,6 В
типовое значение *	

1T313A, 1T313Б	0,46 В
1T313В	0,48 В

Граничное напряжение при $I_Э = 10$ мА 1T313A, 1T313Б,

1T313В не менее	7 В
типовое значение *	10,2 В

Коэффициент шума при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 5$ мА, $R_F = 75$ Ом,

$f = 60$ МГц 1T313В не более	8 дБ
типовое значение *	5,2 дБ

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Емкость эмиттерного перехода при $U_{\text{ЭБ}} = 0,26$ В,

$f = 10$ МГц не более

1T313A	18 пФ
1T313B, GT313B	14 пФ
типовое значение*	
1T313A	11,6 пФ
1T313B	10 пФ
1T313B	10,7 пФ

Пределевые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

при $T \leq 318$ К

1T313A, 1T313B, 1T313B	12 В
GT313A, GT313B, GT313B	15 В
при $T = 343$ К 1T313A, 1T313B, 1T313B	7 В
при $T = 328$ К GT313A, GT313B, GT313B	13 В

Импульсное напряжение коллектор-база при $\tau_i \leq 1$ мкс

и коэффициенте заполнения не более 0,1 1T313A, 1T313B, 1T313B

при $T \leq 318$ К	20 В
при $T = 343$ К	15 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер

при $R_B/R_E < 10$ 1T313A 1T313B, 1T313B	
при $T \leq 318$ К	12 В
при $T = 343$ К	7 В
при $R_E > 500$ Ом $R_B \leq 2$ кОм GT313A, GT313B, GT313B	15 В
при $R_E = 500$ Ом GT313A, GT313B, GT313B	12 В

Постоянное напряжение эмиттер-база 0,7 В

Постоянный ток коллектора

1T313A, 1T313B, 1T313B	50 мА
GT313A GT313B, GT313B	30 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора

при $T = 213 - 315$ К 1T313A, 1T313B 1T313B	100 мВт
при $T = 343$ К 1T313A 1T313B 1T313B	35 мВт
при $T = 213 - 293$ К GT313A, GT313B, GT313B	100 мВт
при $T = 328$ К GT313A GT313B, GT313B	50 мВт

Температура перехода

1T313A 1T313B, 1T313B	358 К
GT313A GT313B GT313B	343 К

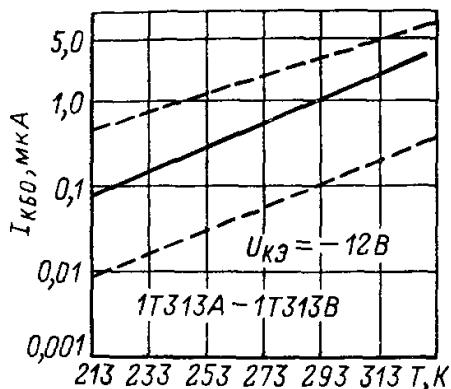
Температура окружающей среды

1T313A, 1T313B, 1T313B	От 213 до 343 К
GT313A, GT313B, GT313B	От 233 до 328 К

Материал взят из источника:

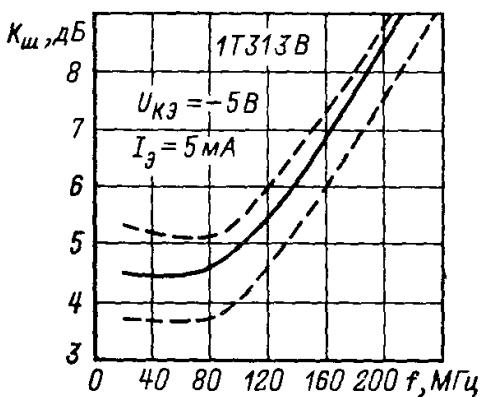
Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

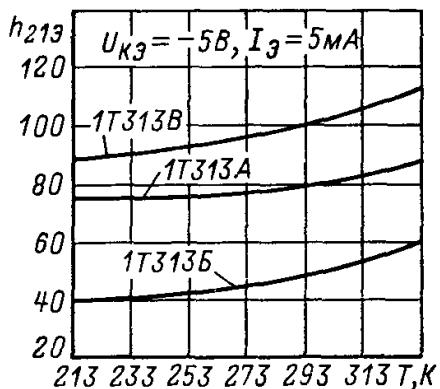


Зона возможных положений зависимости обратного тока коллектора от температуры

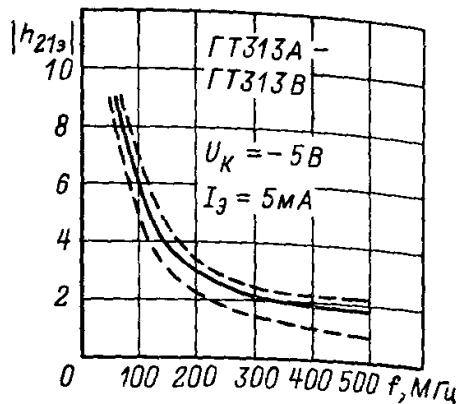
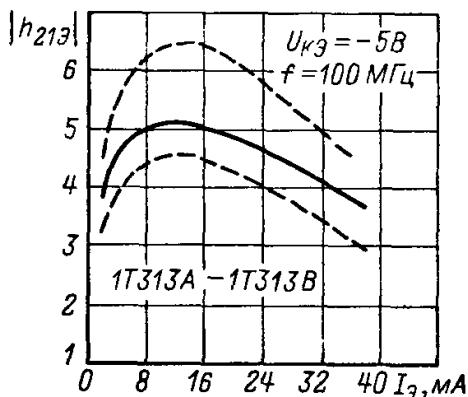
Зона возможных положений зависимости модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зона возможных положений зависимости коэффициента шума от частоты



Зависимость коэффициента передачи тока от температуры



Зона возможных положений зависимости модуля коэффициента передачи тока от частоты